# Laboratorio di Elettronica e Tecniche di Acquisizione Dati 2025-2026

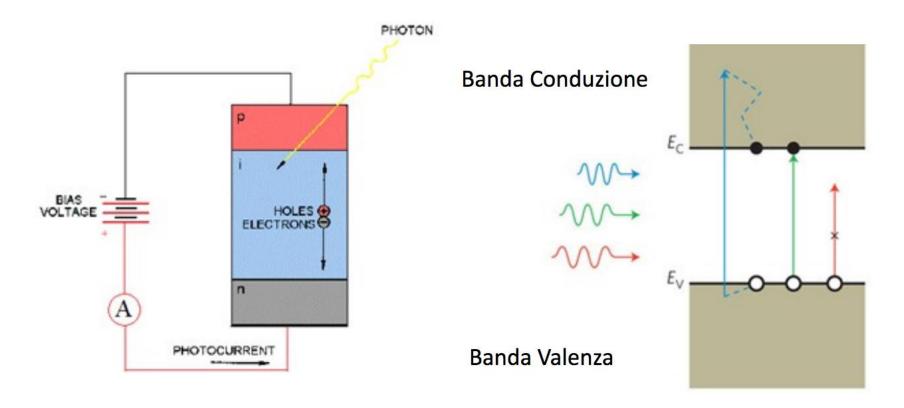
### **Fotodiodo**

cfr. http://www-3.unipv.it/lde/didattica\_elettronicall/photodiode.pdf

 Fotodiodo: trasduttore da segnale ottico a segnale elettrico ("fotorivelatore")



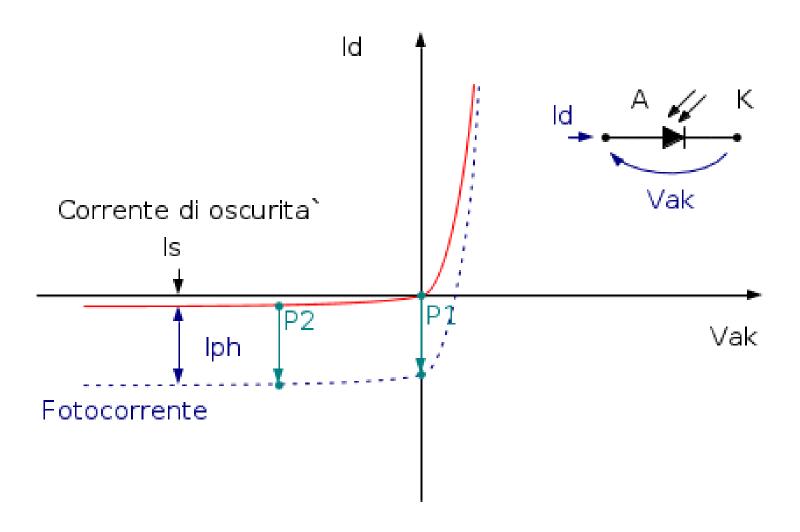
 Diodo a semiconduttore operato con polarizzazione inversa. Quando un fotone con energia E=hv > E<sub>gap</sub> incide nella zona svuotata, può convertire in una coppia elettrone-lacune che contribuisce a una corrente di segnale.



## Fotodiodi

- I fotodiodi sono dispositivi a semiconduttore con struttura PN (o PIN), impiegati come trasduttori di potenza luminosa
- L'energia trasportata dalla radiazione elettromagnetica, assorbita nella regione di svuotamento o nella regione intrinseca, determina la generazione di coppie elettrone/lacuna, che contribuiscono alla formazione di una corrente elettrica.
- La caratteristica tensione corrente di un fotodiodo è dunque uguale a quella di un diodo, con l'aggiunta di un termine di corrente fotogenerata I<sub>ph</sub>:

dove  $I_0$  è la corrente di leakage del diodo,  $V_D$  la tensione ai capi del dispositivo e  $V_T$  la tensione termica (kT/e). Si osservi che, in condizioni di polarizzazione inversa ( $V_D \le 0$ ), la corrente sarà data da  $I_0$  e  $I_{ph}$ , e, addirittura, per  $V_D = 0$ ,  $I_D = -I_{ph}$ .



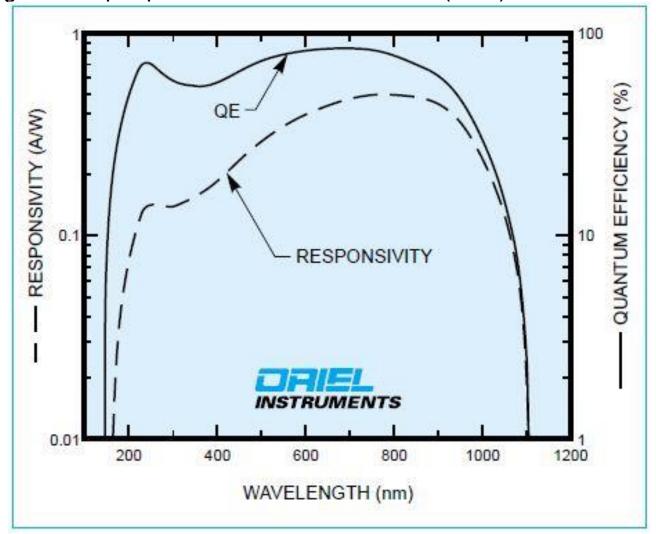
 La corrente fotogenerata I<sub>ph</sub> risulta proporzionale alla potenza luminosa incidente, ovvero al flusso di fotoni che colpiscono il dispositivo:

$$I_{ph} = S \cdot P = \frac{\eta e}{h \nu} P$$
,  $\frac{P}{h \nu} = \#$  fotoni al sec.

- dove S è la sensibilità spettrale, η è l'efficienza quantica, e è la carica dell'elettrone (1.602 10<sup>-19</sup> C), P è la potenza dell'onda elettromagnetica incidente, h è la costante di Plank (6.625 10<sup>-34</sup> J·s) e v è la frequenza dell'onda elettromagnetica.
- altri parametri caratteristici di un fotodiodo sono la linearità, la corrente di buio, la capacità di giunzione, la tensione di breakdown ed il tempo di risposta

- Efficienza quantica: probabilità di creazione di una coppia e-h per fotone incidente
- Responsività: corrente generata per potenza luminosa incidente (A/W).

Entrambe sono funzione della lunghezza d'onda della luce incidente, ovvero dell' energia dei quanti di luce.

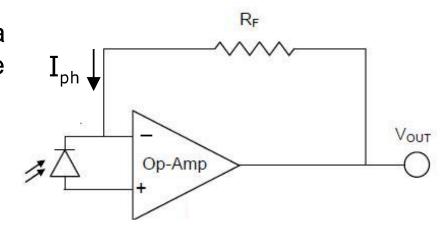


# **Applicazioni**

Settore	Impiego o dispositivo
Fotocamere	Misuratori di intensità luminosa, controllo automatico dell'otturatore, auto-focus, controllo del flash
Strumentazione medica	Scanner per TAC – rivelazione di raggi X, analisi biologiche (e.g. sul sangue), ossimetria
Dispositivi di sicurezza	Rivelatori di fumo e di fiamma, apparati a raggi X per ispezioni di aeromobili, rivelatori di intrusione
Automotive	Headlight dimmer, rivelatore di luce solare (per regolazione della climatizzazione)
Comunicazioni	Convertitori opto-elettronici, controllo ottico remoto
Industria	Lettori di codici a barre, encoder, sensori di posizione, misura della densità del toner nelle fotocopiatrici

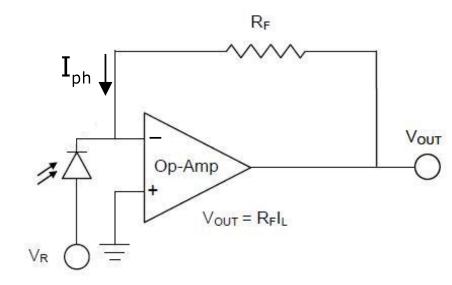
## Modalità operative

 Modalità fotovoltaica: il fotodiodo opera in assenza di tensioni di polarizzazione ed è in grado di erogare potenza elettrica.



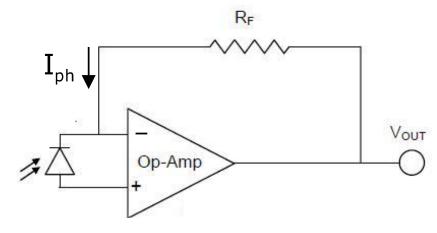
 Modalità fotoconduttiva: il fotodiodo opera in condizioni di polarizzazione inversa o nulla, V<sub>D</sub>≤0 e si comporta come un generatore di corrente. In particolare se V<sub>D</sub>=0:

$$I_{\text{D}} = -I_{\text{ph}}$$



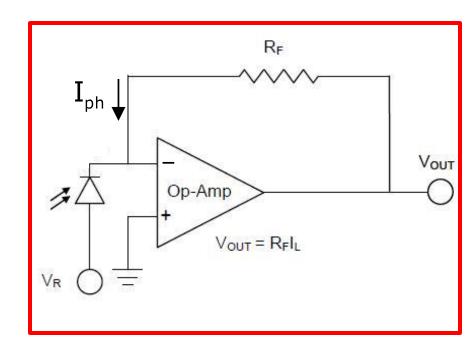
## Modalità operative

 Modalità fotovoltaica: il fotodiodo opera in assenza di tensioni di polarizzazione ed è in grado di erogare potenza elettrica.



 Modalità fotoconduttiva: il fotodiodo opera in condizioni di polarizzazione inversa o nulla, V<sub>D</sub>≤0 e si comporta come un generatore di corrente. In particolare se V<sub>D</sub>=0:

$$I_{\text{D}} = -I_{\text{ph}}$$

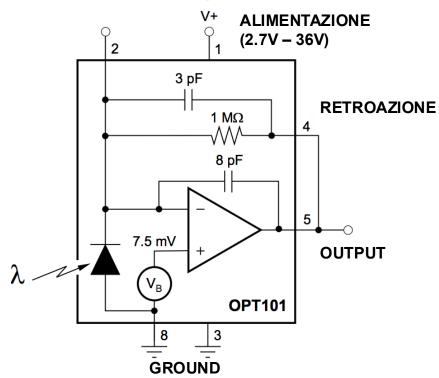




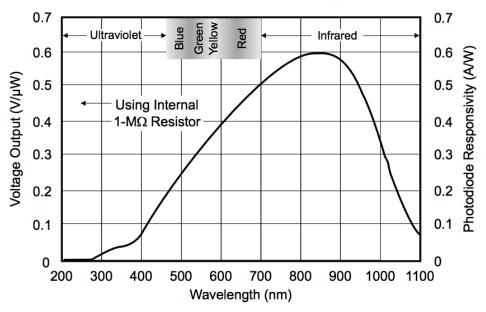
Fotodiodo con amplificatore transimpedenza on-chip

(integra un op-amp con feedback negativo che trasforma il segnale in corrente in segnale in tensione)

#### **Block Diagram**



#### Spectral Responsivity





OPT101

SBBS002B-JANUARY 1994-REVISED JUNE 2015

#### **OPT101 Monolithic Photodiode and Single-Supply Transimpedance Amplifier**

#### 1 Features

- Single Supply: 2.7 to 36 V
- Photodiode Size: 0.090 inch × 0.090 inch (2.29 mm × 2.29 mm)
- Internal 1-MΩ Feedback Resistor
- High Responsivity: 0.45 A/W (650 nm)
- Bandwidth: 14 kHz at  $R_F = 1 M\Omega$
- Low Quiescent Current: 120 μA
- Packages: Clear Plastic 8-pin PDIP and J-Lead SOP

#### 2 Applications

- Medical Instrumentation
- Laboratory Instrumentation
- Position and Proximity Sensors
- Photographic Analyzers
- Barcode Scanners
- Smoke Detectors
- · Currency Changers

#### 3 Description

The OPT101 is a monolithic photodiode with on-chip transimpedance amplifier. The integrated combination of photodiode and transimpedance amplifier on a single chip eliminates the problems commonly encountered in discrete designs, such as leakage current errors, noise pick-up, and gain peaking as a result of stray capacitance. Output voltage increases linearly with light intensity. The amplifier is designed for single or dual power-supply operation.

The 0.09 inch × 0.09 inch (2.29 mm × 2.29 mm) photodiode operates in the photoconductive mode for excellent linearity and low dark current.

The OPT101 operates from 2.7 V to 36 V supplies and quiescent current is only 120  $\mu$ A. This device is available in clear plastic 8-pin PDIP, and J-lead SOP for surface mounting. The temperature range is 0°C to 70°C.

#### Device Information<sup>(1)</sup>

PART NUMBER	PACKAGE	BODY SIZE (NOM)
ODT404	PDIP (8)	9.53 mm × 6.52 mm
OPT101	SOP (8)	9.52 mm × 6.52 mm

(1) For all available packages, see the package option addendum at the end of the data sheet.



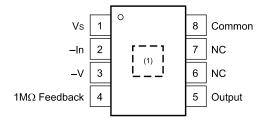
www.ti.com

**OPT101** 

SBBS002B - JANUARY 1994-REVISED JUNE 2015

#### 5 Pin Configuration and Functions

#### DTL and NTC Packages 8-pin SOP and 8-pin PDIP Top View



(1) Photodiode location.

#### **Pin Functions**

PIN I/O		1/0	DESCRIPTION	
NO.	NAME	1/0	DESCRIPTION	
1	V <sub>S</sub>	Power	Power supply of device. Apply 2.7 V to 36 V relative to –V pin.	
2	–In	Input	Negative input of op amp and the cathode of the photodiode. Either do not connect, or apply additional op amp feedback.	
3	-V	Power	Most negative power supply. Connect to ground or a negative voltage that meets the recommended operating conditions.	
4	1MΩ Feedback	Input	Connection to internal feedback network. Typically connect to Output, pin 5.	
5	Output	Output	Output of device.	
6	NC	_	Do not connect	
7	NC	_	Do not connect	
8	Common	Input	Anode of the photodiode. Typically, connect to ground.	

#### 6.5 Electrical Characteristics

At  $T_A$  = 25°C,  $V_S$  = 2.7 V to 36 V,  $\lambda$  = 650 nm, internal 1-M $\Omega$  feedback resistor, and  $R_L$  = 10 k $\Omega$  (unless otherwise noted)

	PARAMETER	TEST CONDITIONS	MIN 7	YP MAX	UNIT
RESPONSIN	/ITY		-		
	Photodiode current		(	).45	A/W
	Voltage output		(	1.45	V/µW
	Voltage output vs temperature			100	ppm/°C
	Unit-to-unit variation		±	5%	
	Nonlinearity <sup>(1)</sup>	Full-scale (FS) output = 24 V	±C	.01	% of FS
	D	0.090 in × 0.090 in	0.	008	in <sup>2</sup>
	Photodiode area	2.29 mm × 2.29 mm		5.2	mm <sup>2</sup>
DARK ERR	ORS, RTO <sup>(2)</sup>		-		!
	Offset voltage, output		5	7.5 10	mV
	Offset voltage vs temperature			±10	μV/°C
	Offset voltage vs power supply	V <sub>S</sub> = 2.7 V to 36 V		10 100	μV/V
	Voltage noise, dark	$f_B = 0.1 \text{ Hz to } 20 \text{ kHz}, V_S = 15 \text{ V}, V_{PIN3} = -15 \text{ V}$		300	μVrms
TRANSIMPI	EDANCE GAIN				
	Resistor			1	МΩ
	Tolerance		±0.	5% ±2%	
	Tolerance vs temperature			±50	ppm/°C
REQUENC	Y RESPONSE				
	Bandwidth	V <sub>OUT</sub> = 10 V <sub>PP</sub>		14	kHz
	Rise and fall time	10% to 90%, V <sub>OUT</sub> = 10-V step		28	μs
		to 0.05%, V <sub>OUT</sub> = 10-V step		160	μs
	Settling time	to 0.1%, V <sub>OUT</sub> = 10-V step		80	μs
		to 1%, V <sub>OUT</sub> = 10-V step		70	μs
	Overload recovery	100%, return to linear operation		50	μs
OUTPUT					
	Voltage output, high		$(V_S) - 1.3 (V_S) - 1$	.15	V
	Capacitive load, stable operation			10	nF
	Short-circuit current	V <sub>S</sub> = 36 V		15	mA
POWER SU	PPLY				
	Quincoant aurrent	Dark, V <sub>PIN3</sub> = 0 V		120	μΑ
	Quiescent current	R <sub>L</sub> = ∞, V <sub>OUT</sub> = 10 V		220	μA

- (1) Deviation in percent of full scale from best-fit straight line.
- (2) Referred to output. Includes all error sources.

#### 6.6 Electrical Characteristics: Photodiode

At  $T_A = 25$ °C and  $V_S = 2.7$  V to 36 V (unless otherwise noted)

PARAMETER	TEST CONDITIONS	MIN TYP MAX	UNIT
Photodiode area	0.090 in × 0.090 in	0.008	in <sup>2</sup>
Priotodiode area	2.29 mm × 2.29 mm	5.2	mm <sup>2</sup>
	λ = 650 nm	0.45	A/W
Current responsivity		865	(µA/W)/cm
Dark current	V <sub>DIODE</sub> = 7.5 mV	2.5	pA
Dark current vs temperature	V <sub>DIODE</sub> = 7.5 mV	Doubles every 7°C	_
Capacitance		1200	pF

#### 6.7 Electrical Characteristics: Op Amp<sup>(1)</sup>

At  $T_A$  = 25°C,  $V_S$  = 2.7 V to 36 V,  $\lambda$  = 650 nm, internal 1-M $\Omega$  feedback resistor, and  $R_L$  = 10 k $\Omega$  (unless otherwise noted)

PARAMETER	TEST CONDITIONS	MIN TYP MA	X UNIT
INPUT		,	
Offset voltage		±0.5	mV
vs temperature		±2.5	μV/°C
vs power supply		10	μV/V
Input bias current	(–) input	165	pA
vs temperature	(–) input	Doubles every 10°C	_
land time and are a	Differential	400    5	MΩ    pF
Input impedance	Common-mode	250    35	GΩ    pF
Common-mode input voltage range	Linear operation	0 to (V <sub>S</sub> – 1)	V
Common-mode rejection		90	dB
OPEN-LOOP GAIN			
Open-loop voltage gain		90	dB
FREQUENCY RESPONSE		·	
Gain bandwidth product <sup>(2)</sup>		2	MHz
Slew rate		1	V/µs
	0.05%	8.0	μs
Settling time	0.1%	7.7	μs
	1%	5.8	μs
ОИТРИТ			
Voltage output, high		(V <sub>S</sub> ) – 1.3 (V <sub>S</sub> ) – 1.15	V
Short-circuit current	V <sub>S</sub> = 36 V	15	mA
POWER SUPPLY			
Ovice court avenue at	Dark, V <sub>PIN3</sub> = 0 V	120	μA
Quiescent current	R <sub>L</sub> = ∞, V <sub>OUT</sub> = 10 V	220	μA

<sup>(1)</sup> Op amp specifications provided for information and comparison only.(2) Stable gains ≥ 10 V/V.